統合計画用リニアック-3GeV シンクロトロン間ビーム輸送系の設計

松岡雅則^{1,A)}、山本風海^{A)}、長谷川和男^{A)}、下崎義人^{B)}、池上雅紀^{B)}、加藤隆夫^{B)} ^{A)}日本原子力研究所東海研究所 〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4 ^{B)}高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1

概要

日本原子力研究所(原研)と高エネルギー加速器 研究機構(KEK)は共同して、大強度陽子加速器計画を 推進している。この加速器は、400MeVリニアックと、 3GeV シンクロトロンリングおよび 50GeV シンクロ トロンリングから構成される。本発表は、400MeVリ ニアックと 3GeV シンクロトロンリングをつなぐビ ーム輸送系(L3BT)に関するものである。ここでは、 L3BT の各機器仕様を決めるために実施した基本設 計検討結果について述べる。

1.はじめに

統合計画加速器^[1]は、400MeV リニアック(将来拡 張で 600MeV)、3GeV シンクロトロンリング、50GeV シンクロトロンリングから構成される。表 1 に、統 合計画加速器リニアックの基本仕様を示す^[2]。

本加速器の大きな特徴は、非常に大強度のビーム を加速するということである。このため、L3BT ライ ンには、空間電荷による影響を受けにくい設計が求 められる。さらに、L3BT では、リニアックで加速さ れたビームをその質を劣化させることなく、輸送す るだけでなく、3GeV リング入射の際にロスが発生し ないよう、ビーム仕様を整える必要がある(表 1)。こ の 3GeV リングからの要求仕様を得るため、L3BT ラ インには、横方向エミッタンス抑制用としてスクレ ーパが、運動量拡がり抑制用としてデバンチャーが、 それぞれ配されている^[3]。

表1 統合計画加速器	器リニアックビーム仕様
ビームエネルギー	400MeV
ビーム電流	50mA
加速周波数	324MHz(RFQ,DTL,SDTL)
	972MHz(ACS)
パルス幅	500 µ s
繰り返し周波数	50Hz
<3GeV リングからの要求	仕様>
エミッタンス(横方向)	$4 \pi^*$ mm*mrad
	(un-normalized,100%)
運動量拡がり	±0.1%以内

2.L3BT の基本仕様

図1に、L3BT ラインのレイアウトを示す。L3BT ライン全長は176mで、輸送用の各種電磁石、スクレ ーパ等から構成される(表 2)。各磁石の磁場強度は、 ローレンツストリッピングによるビームロスが1 W/mを越えることのないよう設定されている。



	·L\ 2	1501	21.02.10				
ビーム	ライ	ン全長	(セプ	タム	電磁石	前ま	で)

台
8台
台
台
箇所

1) E-mail: <u>matsuoka@linac.tokai.jaeri.go.jp</u>、三菱重工業(株)より出向

3. ビームラインの設計

3.1 ビームラインの構成

(1)直線部

直線部は、400MeV リニアック出口から第1アーク 部に至るまでのラインである。ACS から出力された ビームは、位相空間上にバンチされており、空間電 荷の影響を強く受ける。そこで、直線部のラティス は、ACS と同じくダブレット構造とし、極力横方向 の連続性を保った。

(2)第1アーク部^[4]

第1アーク部は、南北に走る400MeVリニアック から延長されたビームラインを東西のラインに偏向 するためのラインである。ラティス構成は、 DBA(Double Bend Achromatic)を3つ組み合わせたも ので、空間電荷の影響を受けにくいアークとした。 図2に、TRACE3Dによるビームエンベロープ解析結 果を示す。磁石の調整をしなくても電流の有無でア ーク出口のTwiss parameters が大きく変化しない。



(a)電流 0mA



(b)電流 150mA (実際のビームのバンチの周波数は 324MHz であるので、空間電荷の評価のために、972MHz での等価な値 150mA を用いた)

図 2 第 1 アーク部のビームエンベロープ (TRACE3D による解析結果)

(3) スクレーパ部^[3]

スクレーパ部は、横方向のビームハローを除去す るために、第1アークと第2アークの間の東西に走 る直線部に設けられる。1 周期あたりの位相進みが 45°の FODO ラインで構成され、8ヶ所あるスクレ ーパで、不要なビームは荷電変換フォイルを通過し て陽子ビームに変換される。変換されたビームは、 第2アーク部の最初の偏向電磁石で主軌道と逆の方 向に曲げられ、コンクリートに埋め込まれた鉄製ビ ームダンプに捨てられる。

(4) 第2アーク部

第2アーク部は、3GeV へ入射するための入射角を 得るためのアークである。偏向角は 17.6°で、一組 の DBA ラティスで構成される。

(5)入射部

入射部には、セプタム電磁石等、入射のための機器が並べられる。実際には、3GeVリングにある荷電 変換フォイル部で入射に最適な条件が与えられ、これに応じた磁石の最適化が必要となるが、ここでは、 セプタム電磁石の手前までの解析に留める。

以上の各部の間には、マッチングセクションが設 けられ、スムーズな 関数変換が行われる。ここで は、このセクションの磁石配置および強度の条件を、 MAD および TRACE3D を用いて求めた。図3には、 MAD で計算された、L3BT 系全体の 関数を示す(空 間電荷なし)。各セクション間で急激な 関数の変動 がないことが分かる。



3.2 デバンチャー電圧の最適化

表1に示した3GeVリングからの要求仕様のうち、 運動量拡がり±0.1%を満足させるために、デバンチ ャーが用いられる。デバンチャーには、バンチされ たビームを縦方向の位相空間上で広げることにより、 空間電荷の影響で生じる縦方向エミッタンス増大を 軽減すると共に、3GeV入射部で、運動量拡がりが最 小になるよう調整する働きがある。L3BT ラインには、 第1アーク部の直前と直後に、合わせて2台のデバ ンチャーが設置される。

図4にデバンチャー1(ACS出口から21.2mの位置) の電圧を3.0MV 一定とし、アーク部直後のデバンチャー(デバンチャー2)の電圧および設置場所を変化 させたときの3GeV リング入口における運動量拡が りの変化を示した。デバンチャー2の位置は、極力下 流に設置するのが有利であることが分かる。



図4 デバンチャーの電圧と3GeV入口での運動量 拡がりの関係(TRACE3D による解析結果)

3.3 ビームシミュレーションおよび横方向ス クレーパの挙動

3.1、3.2 項で得られた条件で、ビームシミュレーションを実施した。解析には、PARMILA コードを用いた。解析結果を表 3、図 6 に示す。400MeV 出口から 3 GeV リング入口まで、大きなエミッタンス増加もなく輸送でき、要求仕様を満足している。

横方向のエミッタンス拡がりを抑制するために設 置されるスクレーパ部のビーム挙動を、PARMILA コ ードを用いてシミュレーションした。スクレーパ設 置部での 関数は、約 14.5m であるので、仕様の 4 π mm*mrad のビーム径は、 $\sqrt{\epsilon\beta} = \sqrt{4*14.5} = 7.6$ mm である。実際のスクレーパでは、この位置に荷電変 換フォイルを配し、仕様を満足しないビームを陽子 に変換し、第2アークの偏向電磁石で逆方向に曲げ てビームダンプに導く構成となっている。ここでは、 スクレーパ部に配置される荷電変換フォイルをスリ ットで模擬し、これに衝突するとビームが消滅する という条件で解析を行った。スクレーパの効果を見 るために、表1に示した横方向エミッタンスの3倍 のエミッタンスを持つビームをインプット条件とし た。結果を図7に示す。スクレーパセクションで、 ビームが適切に削られている様子が確認できる。

表 3 L 3 B T 出口のビーム仕様解析結果 横方向エミッタンス(99.9%)

水平方向	1.82 π *mm*mrad
垂直方向	1.82 π *mm*mrad
運動量拡がり	0.048%(半幅)
	(99.9%エミッタンスより算出)



図 6 L3BT ラインのビームシミュレーション結果 (上段:L3BT入口、下段:L3BT出口)



図7 横方向エミッタンス(99.9%)の変化 (スクレーパの動作確認のため、大きなエミッタンスで計算した)

4.まとめ

L3BT ラインの主要な電磁石、デバンチャー、コリ メータの仕様をビームエンベロープ解析、ビームシ ミュレーションにより検討した。今後は、3GeV での 入射スキームとのマッチングを中心に検討を行う予 定である。

参考文献

- JAERI/KEK Joint Project Team, "Accelerator technical design report for high-intensity proton accelerator facility project", 2002
 伊藤 崇 "大強度陽子加速器計画用リニアックの開発
- [2]伊藤 崇 "大強度陽子加速器計画用リニアックの開発 状況",本研究会
- [3]山本風海, "ビームトランスポートシステム()-ビーム ロス局所化の設計-", OHO2001
- [4]加藤隆夫, "L3BT デザイン(1)アーク部について",内部資料